

Europäisches Patentamt **European Patent Office**

Office européen des brevets

Bescheinigung

Certificate

Attestation

078453 10×1 ILchmann

Die angehefteten Unterlagen stimmen mit der ursprünglich eingereichten Fassung der auf dem nächsten Blatt bezeichneten europäischen Patentanmeldung überein. The attached documents are exact copies of the European patent application described on the following page, as originally filed.

Les documents fixés à cette attestation sont conformes à la version initialement déposée de la demande de brevet européen spécifiée à la page suivante.

Patentanmeldung Nr.

Patent application No. Demande de brevet nº

02360362.4

Der Präsident des Europäischen Patentamts; Im Auftrag

For the President of the European Patent Office

Le Président de l'Office européen des brevets p.o.

R C van Dijk

DEN HAAG, DEN THE HAGUE, LA HAYE, LE

10/03/03



Eur päisches **Patentamt**

European **Patent Office**

Office européen des brevets

Blatt 2 der Bescheinigung Sheet 2 of the certificate Page 2 de l'attestation

Anmeldung Nr.: Application no.: Demande n°:

02360362.4

Anmeldetag: Date of filing: Date de dépôt:

18/12/02

Anmelder: Applicant(s): Demandeur(s): **ALCATEL** 75008 Paris **FRANCE**

Bezeichnung der Erfindung: Title of the invention: Titre de l'invention:

Ein Konverter von ECL nach CMOS und ein Netzwerkelement zum Übertragen von Signalen

In Anspruch genommene Prioriät(en) / Priority(ies) claimed / Priorité(s) revendiquée(s)

Tag: Date:

State: Pays:

File no. Numéro de dépôt:

Internationale Patentklassifikation: International Patent classification:

Classification internationale des brevets:

Am Anmeldetag benannte Vertragstaaten: Contracting states designated at date of filing: Etats contractants désignés lors du depôt:

AT/BG/BE/CH/CY/CZ/DE/DK/EE/ES/FI/FR/GB/GR/IE/IT/LI/LU/MC/NL/

Bemerkungen: Remarks: Remarques:

Ein Konverter von ECL nach CMOS und ein Netzwerkelement zum Übertragen von Signalen

Die Erfindung betrifft einen Konverter von ECL nach CMOS nach dem

5 Oberbegriff des Anspruchs 1 und ein Netzwerkelement zum Übertragen von Signalen nach dem Oberbegriff des Anspruchs 5.

Logik-Konverter werden benutzt um unterschiedliche Logik-Level anzupassen. Ein Eingangssignal wird entsprechend der Logik10 Potentialdefinitionen umgesetzt. Der Konverter hat die Aufgabe die Signale mit entsprechender Frequenz zu konvertieren. Solche Signale kommen beispielsweise zwischen aktiven Komponenten innerhalb eines Chips oder zwischen zwei Chips vor. Diese Komponenten können nahe beieinander oder weit auseinender liegen. Beispielsweise können solche Komponenten über einen Bus verbunden sein. Ein weiterer Anwendungsfall ist, wenn die Komponenten in weit voneinander entfernt gelegenen Netzwerkelementen integriert sind.

Signalaustauschende Systeme oder im allgemeinen Telekommunikations20 Systeme und –Netze haben das Ziel (elektrische) Signale zuverlässig,
fehlerlos und so schnell wie möglich auszutauschen. Um dieses Ziel zu
erreichen verwendet man z.B. definierte uniforme Übertragungsraten
(Frequenzen) und definierte Amplituden.

25 Differenzielle Emitter Coupled Logic (ECL) Schaltkreise werden bei der Datenübertrag wegen ihrer höheren Verarbeitungsgeschwindigkeit und ihrer vorteilhaften Signaleigenschaften benutzt. Der differentielle Aspekt dieser Signale mit niedrigen Spannungsniveaus führt beispielsweise zu einem guten Rauschabstand.

Es ist technologisch möglich und wünschenswert ECL-Signale niedrigen

Niveaus in Signale höheren Niveaus, wie die der Complementary

Metaloxyd Semiconductor (CMOS) Logik-Schaltkreise ohne eine
bedeutenden Geschwindigkeitsverlust umzuwandeln, so dass ein solcher

Konverter CMOS-Schaltungen ansteuern kann.

- Bekannte Konverter von ECL nach CMOS setzen den Pegel auf Kosten von Geschwindigkeits- und/oder Treibereigenschaften um. ECL kann schneller geschaltet werden als CMOS, aber Versuche, die Konvertierung zu beschleunigen vermindern häufig die Ausgangstreibereigenschaften des Stromkreises. Die Schriften US Pat. Nr. 5,726,588 oder US Pat. Nr.
- 15 5,426,381 beschreiben Schaltungen mit diesem Nachteil.

Das Konvertieren von ECL-Signalen in CMOS-Signale wird üblicherweise in drei Stufen durchgeführt. Eine Eingangsstufe empfängt und puffert die ECL-Signale, die mit einem Signalhub von wenigen 100mV bezogen auf die positive Betriebsspannung anliegen. Eine Pegelwandlerstufe verschiebt die ECL-Pegel in Richtung der CMOS-Umschaltschwelle und erhöht den Signalhub und eine Ausgangsstufe formt das CMOS kompatible Ausgangssignal.

Die Erfindung geht von einer Konverterschaltung aus, die den oben beschriebenen Nachteil nicht aufweißt. Diese Konverterschaltung ist in dem US Patent No. 6,252,421 beschrieben und in Figur 1 dargestellt.

Diese Schaltung birgt aber die folgenden Nachteile: Als Pegelwandler wird eine bipolare Differenzstufe 20, ..., 24 verwendet, deren Ausgangssignale dann zum Ansteuern von CMOS-Invertern 25, ..., 28 und 37, ..., 40 benutzt werden. Wird diese Anordnung mit niedrigen Betriebspannungen, z.B. unter 3 Volt, betrieben, kann der Ausgangspegel für den Low-Zustand nicht mehr den CMOS-Umschaltpegel, der üblicherweise bei der halben Betriebsspannung liegt, erreichen.

Dies ist durch die Schaltungstechnik des verwendeten Pegelwandlers 20, ...,
24 bedingt. Die Differenzstufe 20, ..., 23 erfordert eine Stromquelle 24, an
der typisch 0.8V abfallen. Weiterhin fällt an den Schalttransistoren 22, 23
der Differenzstufe 20, .., 23 eine Spannung in Höhe der Flussspannung ab.
Typischerweise sind das ebenfalls etwa 0.8V. Wegen des Sättigungseffektes
darf der Kollektor das Basispotential nicht unterschreiten. D.h., der

Ausgangspegel für den Low-Zustand kann nicht unter 1.6V sinken. Die
CMOS-Umschaltschwelle muss also über 1.6V liegen und damit ergibt sich
eine mögliche minimale Betriebsspannung von etwa 1.6V *2 = 3.2V.

Durch eine unsymmetrische Dimensionierung der Inverter 25, ..., 28 und 37, ..., 40, die von der Differenzstufe 20, ..., 23 angesteuert werden, kann diese Spannung noch etwas unterschritten werden. Diese unsymmetrischen Inverter führen aber wiederum zu längeren Schaltzeiten.

Ein weiterer Nachteil der bekannten Lösungen ist auch, dass der
Pegelwandler 20, ..., 24 einen relativ großen Signalhub aufweist, da die bipolare Differenzstufe 20, ..., 23 vom minimalen Pegel für den Low-Zustand auf den Pegel der Betriebspannung für den High-Zustand umschaltet. Durch den großen Signalhub ergeben sich relativ lange Umschaltzeiten.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, differentielle ECL-Eingangsignale in differentielle CMOS-Signale bei niedrigen Betriebsspannungen schnell zu wandeln und dadurch Signale zwischen und in Netzwerkelementen schneller und effizienter zu übertragen.

Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß gelöst durch einen Konverter von ECL nach CMOS mit einer Eingangsstufe, einer Pegelwandlerstufe und einer Ausgangsstufe wobei die Pegelwandlerstufe eine NFET Differenzstufe aufweist. Die Eingangsstufe und/oder die Pegelwandlerstufe hat vorzugsweise eine Regelung der Umschaltschwelle. Und der Konverter von ECL nach CMOS umfasst vorzugsweise Mittel zur Generierung einer Referenzspannung für Stromquellentransistoren, zur Regelung der Umschaltschwelle. Weiterhin weisen diese Mittel zur Regelung der Umschaltschwelle vorzugsweise eine Nachbildung von Teilen des Konverters zur Ermittlung der Referenzspannung auf.

Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß gelöst durch ein Netzwerkelement zum Übertragen von Signalen, das einen Konverter von ECL nach CMOS mit einer Eingangsstufe, einer Pegelwandlerstufe und einer Ausgangsstufe umfasst, wobei die Pegelwandlerstufe eine NFET Differenzstufe aufweist.

Durch eine NFET Differenzstufe werden die ECL Signale in den Bereich der CMOS Umschaltschwelle gebracht. Diese Form der Ansteuerung arbeitet auch bei niedrigen Betriebsspannungen.

25

5

10

15

20

Durch die geringe Anzahl der aktiven Bauelemente wird die Laufzeit der Pegelwandlung stark reduziert. Es werden Laufzeiten unter 200ps erreicht.

Die geringe Anzahl der Bauelemente ist auch vorteilhaft, da der Flächenbedarf der Schaltung gering ist.

Insbesondere ist die Schaltung für niedrige Betriebsspannungen (z.B. 2.5V)
5 geeignet.

Weiterhin ist vorteilhaft, dass die Pegelwandlung unempfindlich gegen Schwankungen der Temperatur, Betriebsspannung und Technologieparameter ist. Dadurch wird die Dimensionierung der einzelnen Bauelemente vereinfacht.

Im folgenden wird die Erfindung unter Zuhilfenahme der beiliegenden Zeichnungen weiter erläutert:

- 15 Figur 1 zeigt einen bekannten Konverter von ECL nach CMOS
 - Figur 2 zeigt einen erfindungsgemäßen Konverter von ECL nach CMOS
- Figur 3 zeigt einen erfindungsgemäßen Konverter von ECL nach CMOS 20 mit Regelung der Umschaltschwelle
 - Figur 4 zeigt ein Beispiel der Pegelverläufe an einem erfindungsgemäßen Konverter von ECL nach CMOS
- 25 Anhand der Figur 2 wird zunächst die prinzipielle Funktionsweise der Schaltung eines Konverters von ECL nach CMOS erläutert.

Der Konverter von ECL nach CMOS setzt sich aus einer Eingangsstufe, einer Pegelwandlerstufe und einer Ausgangsstufe zusammen. Die Eingangsstufe

besteht aus einem Emitterfolger Q1, Q2, N3, N4. Die Pegelwandlerstufe ist eine NFET-Differenzstufe N1, N2, N5, R1, R2, R3. Die nachfolgende Ausgangsstufe setzt sich aus CMOS-Invertern P1/N6, P2/N7, P3/N8, P4/N9 zur Impulsformung zusammen.

5

Durch die Verwendung von NFETs N1 und N2 in der Differenzstufe kann der Ausgangspegel für den Low-Zustand wesentlich tiefer liegen als bei einer bipolaren Lösung, da bei FETs das Drainpotential unter dem Gatepotential liegen darf.

10

25

Weiterhin wird der Signalhub der Differenzstufe N1, N2, N5, R1, R2, R3 durch den Widerstand R1 verringert.

Die Dimensionierung dieses Pegelwandlers ist so, dass bei vorgegebenem

Strom durch den Pegelwandler (durch Vref bestimmt) der Pegel für den
High-Zustand durch den Spannungsabfall an R1 bestimmt ist und der Pegel
für den Low-Zustand durch den Spannungsabfall an R1 und R2 oder R3
bestimmt ist. Die Differenzstufe ist so ausgebildet, dass die Transistoren bei
einem definiertem ECL-Eingangssignal an der Eingangsstufe entweder

durchgeschaltet oder gesperrt sind.

In der Differenzstufe ist dann abhängig von den Gatepotentialen entweder N1 oder N2 leitend. Ist z.B. N1 (durch ein höheres Gatepotential als an N2) eingeschaltet, fließt der Strom durch R1, R2, N1 und N5. Das Drainpotential LS+ von N1 hat dann Low-Potential (Spannungsabfall an R1 und R2) und das Drainpotential LS- von N2 hat dann High-Potential (nur Spannungsabfall an R1, da durch R3 kein Strom fließt). Die durch R1 und R2/R3 eingestellten Pegel sollten symmetrisch zur Umschaltschwelle der

angesteuerten CMOS Inverter P1/N6, P3/N8 sein um ein schnelles Umschalten zu erreichen.

In der ECL-Technologie lassen sich kürzere Umschaltzeiten durch erhöhen der Ströme in den Differenzstufen erreichen. Dies hat den Nachteil, dass sich dadurch auch die Verlustleistung erhöht und sich das beispielsweise nachteilig auf die Integrationsdichte und Leistungsaufnahme auswirkt.

Anhand der Figur 3 wird erläutert wie ein Konverter von ECL nach CMOS mit zusätzlicher Regelung der Umschaltschwelle eine weitere Verringerung der Umschaltzeit ohne Erhöhung der Verlustleistung ermöglicht.

Durch eine Verringerung des Signalhubs der Differenzstufe N1, N2, N5, R1, R2, R3 wird die Umschaltzeit verringert ohne die Verlustleistung zu erhöhen. Um bei einem reduzierten Signalhub eine sichere Funktion des Konverters auch bei Schwankungen von Temperatur, Betriebsspannung und Technologieparametern zu gewährleisten, wird die Referenzspannung an den Stromquellentransistoren N3, N4, N5 geregelt. Dabei wird die Umschaltschwelle der CMOS Inverter als Regelnormal verwendet.

Dieses Regelnormal wird von einem Operationsverstärker OpAmp mit einer künstlich erzeugten Spannung verglichen, die der Mitte des Signalhubs der Differenzstufe entspricht. Die Regelung besteht aus dem Operationsverstärker OpAmp, einer Nachbildung oder Dummy P1_D, N6_D des CMOS Inverters P3, N8 oder P1, N6 und einer Nachbildung
 R1_D, R2A_D, R2B_D, N5_D der Differenzstufe N1, N2, N5, R1, R2, R3. In der Nachbildung der Differenzstufe hat R1_D den gleichen Wert wie R1 und N5_D hat die gleiche Dimensionierung wie N5. Der Widerstand R2 der Differenzstufe wurde in zwei gleich große Widerstände R2A_D und R2B_D aufgeteilt. Die Spannung zwischen den Widerständen R2A_D und R2B_D

5

10

der Nachbildung R1_D, R2A_D, R2B_D, N5_D der Differenzstufe N1, N2, N5, R1, R2, R3 entspricht genau der Mitte des Signalhubs zwischen LS+ und LS-.

Die Schaltschwelle der CMOS Inverter P1, N6 oder P3, N8 wird durch einen Kurzschluss der Nachbildung P1_D, N6_D des CMOS Inverters erzeugt. Der Operationsverstärker OpAmp zieht über die Regelung des Stromes durch N5_D das künstliche Mittenpotential in der Nachbildung der Differenzstufe auf die Schaltschwelle des CMOS Inverters.

10

Da die Widerstände und NFETs von der Nachbildung und der Differenzstufe gleich sind, stellen sich in der originalen Differenzstufe die gleichen Pegel ein. Dadurch sind die Ausgangspegel der Differenzstufe immer auf die Schaltschwelle der CMOS Inverter zentriert.

15

20

Figur 4 zeigt die Pegelverläufe am ECL/CMOS Pegelwandler für eine Betriebsspannung von 2.5 Volt. ECL+/ECL- sind die differentiellen ECL Eingangsignale mit einem Signalhub von 200mV, LS+/LS- sind die Ausgangsspannungen des Pegelwandlers und CMOS+/CMOS- zeigt die CMOS Ausgangssignale.

Ansprüche

5

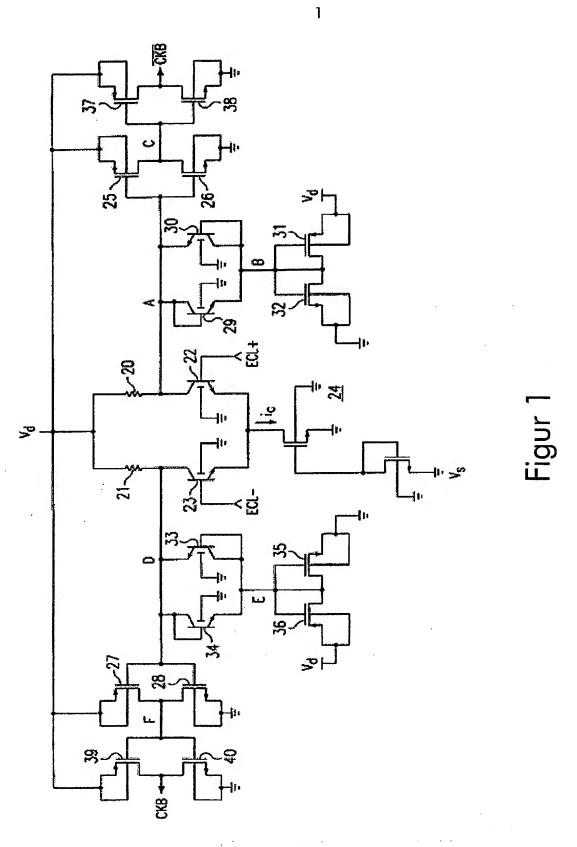
20

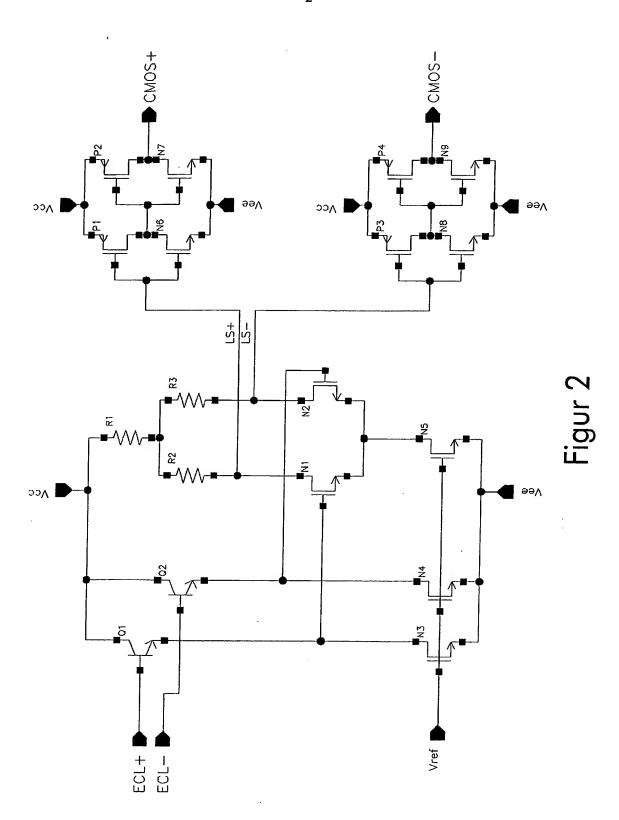
- Konverter von ECL nach CMOS mit einer Eingangsstufe (Q1, Q2, N3, N4), einer Pegelwandlerstufe (N1, N2, N5, R1, R2, R3) und einer Ausgangsstufe (P1, P2, P3, P4, N6, N7, N8, N9), dadurch gekennzeichnet, dass die Pegelwandlerstufe (N1, N2, N5, R1, R2, R3) eine NFET Differenzstufe N1, N2 aufweist.
- Der Konverter von ECL nach CMOS nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Eingangsstufe (Q1, Q2, N3, N4) und/oder die
 Pegelwandlerstufe (N1, N2, N5, R1, R2, R3) eine Regelung der Umschaltschwelle hat.
- Der Konverter von ECL nach CMOS nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass der Konverter Mittel zur Generierung einer Referenzspannung für Stromquellentransistoren (N3, N4, N5) umfasst, zur Regelung der Umschaltschwelle.
 - 4. Der Konverter von ECL nach CMOS nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Mittel zur Generierung einer Referenzspannung eine Nachbildung (P1_D, N6_D, OpAmp, N5_D, R1_D, R2A_D. R2B_D) von Teilen des Konverters zur Ermittlung der Referenzspannung aufweisen.
 - 5. Ein Netzwerkelement zum Übertragen von Signalen, das einen Konverter von ECL nach CMOS mit einer Eingangsstufe (Q1, Q2, N3, N4), einer Pegelwandlerstufe (N1, N2, N5, R1, R2, R3) und einer Ausgangsstufe (P1, P2, P3, P4, N6, N7, N8, N9) umfasst, dadurch gekennzeichnet, dass die Pegelwandlerstufe (N1, N2, N5, R1, R2, R3) eine NFET Differenzstufe N1, N2 aufweist.

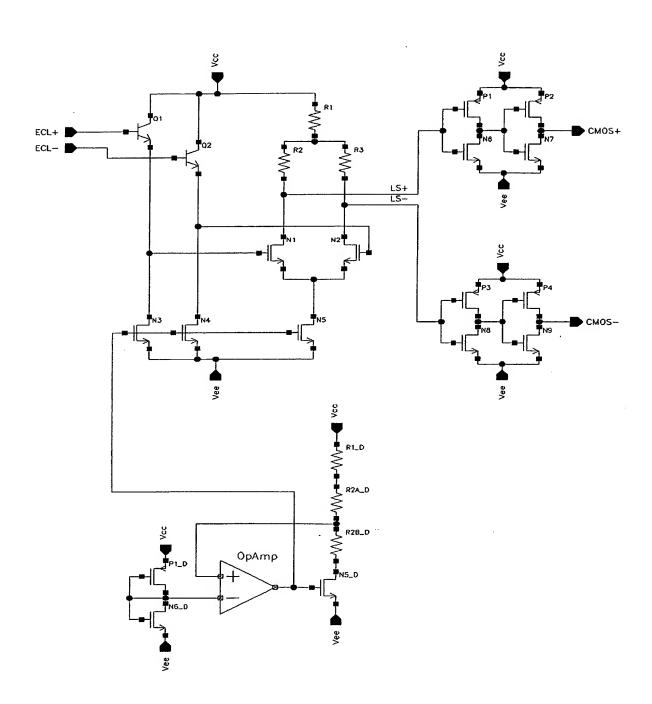
Zusammenfassung

Die Erfindung betrifft einen Konverter von ECL nach CMOS mit einer Eingangsstufe (Q1, Q2, N3, N4), einer Pegelwandlerstufe, (N1, N2, N5, R1, R2, R3), die eine NFET Differenzstufe (N1, N2) aufweist, und einer Ausgangsstufe (P1, P2, P3, P4, N6, N7, N8, N9), sowie ein Netzwerkelement zum Übertragen von Signalen, das einen Konverter von ECL nach CMOS mit einer Eingangsstufe (Q1, Q2, N3, N4), einer Pegelwandlerstufe (N1, N2, N5, R1, R2, R3) und einer Ausgangsstufe (P1, P2, P3, P4, N6, N7, N8, N9) umfasst, wobei die Pegelwandlerstufe (N1, N2, N5, R1, R2, R3) eine NFET Differenzstufe (N1, N2) aufweist.

(Figur 3)







FIGUR 3



